

### СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхема интегральная 564ТЛ1ВК соответствует техническим условиям АЕЯР.431200.150-31 ТУ; ОСМ564ТЛ1ВК - АЕЯР.431200.150-31 ТУ и ПО.070.052 и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Дата

Штамп ОТК \_\_\_\_\_ Штамп представителя заказчика \_\_\_\_\_

Перепроверка произведена \_\_\_\_\_  
Дата

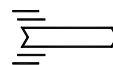
Приняты по извещению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Дата

Штамп ОТК \_\_\_\_\_ Штамп представителя заказчика \_\_\_\_\_

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«ВНИМАНИЕ-Соблюдайте меры предосторожности при работе – ПРИБОРЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ».

Допустимое значение статического потенциала 200 В.



### МИКРОСХЕМЫ 564ТЛ1 ВК, ОСМ564ТЛ1 ВК

Код ОКП : 6331313325 – 564ТЛ1 ВК, ОСМ564ТЛ1 ВК

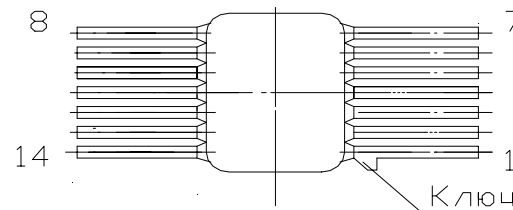
#### ЭТИКЕТКА

ЛСАР.431256.001 ЭТ

Микросхемы интегральные 564ТЛ1 ВК, ОСМ564ТЛ1 ВК – четыре триггера Шмитта с входной логикой “2И – НЕ”.

Шифр кода маркировки микросхемы 564ТЛ1 ВК – 1КТЛ1 в соответствии с АЕЯР.431200.150 ТУ; ОСМ564ТЛ1 ВК – ОСМ1КТЛ1 в соответствии с АЕЯР.431200.150 ТУ и ПО.070.052.

#### Схема расположения выводов



Нумерация выводов показана условно.

Ключ показывает начало отсчета выводов.

Масса не более 1,0 г.

#### Таблица назначения выводов

Обозначение вывода	Назначение вывода
1	Вход 1N1
2	Вход 1N2
3	Выход OUT1
4	Выход OUT2
5	Вход 1N3
6	Вход 1N4
7	Общий GND
8	Вход 1N5
9	Вход 1N6
10	Выход OUT3
11	Выход OUT4
12	Вход 1N8
13	Вход 1N7
14	Питание Ucc

<b>ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b> при температуре (25 ± 10)° С			
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U <sub>CC</sub> =10,0 В; U <sub>I</sub> =10,0 В	U <sub>OL</sub>	-	0,05
Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U <sub>CC</sub> =10,0 В; U <sub>I</sub> =0 В	U <sub>OH</sub>	9,95	-
Входной ток низкого уровня, мкА, при: U <sub>CC</sub> =15,0 В	I <sub>IL</sub>	20,1	-
Входной ток высокого уровня, мкА, при: U <sub>CC</sub> =15,0 В	I <sub>IH</sub>	-	0,1
Выходной ток низкого уровня, мА, при: U <sub>CC</sub> =10,0 В; U <sub>O</sub> =0,5 В	I <sub>OL</sub>	1,3	-
Выходной ток высокого уровня, мА, при: U <sub>CC</sub> =10,0 В; U <sub>O</sub> =9,5 В	I <sub>OH</sub>	- 1,3	-
Ток потребления, мкА, при: U <sub>CC</sub> = 10,0 В	I <sub>CC</sub>	-	2,0
Время задержки распространения сигнала при включении и выключении, нс, при: U <sub>CC</sub> =10,0 В; C <sub>L</sub> = 50 пФ; R <sub>L</sub> = 200 кОм	t <sub>PHL</sub> t <sub>PLH</sub>	-	300
<p>Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:</p> <p>- золото</p> <p>Цветных металлов не содержится.</p>			

<b>НАДЕЖНОСТЬ</b>
<p>Минимальная наработка (Т<sub>нм</sub>) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в облегченных режимах при: U<sub>CC</sub>=5 410 В; C<sub>L</sub>≤500 пФ; U<sub>CC</sub> 10,2 В/U<sub>I</sub> / минус 0,2 В - 120000ч.</p> <p>Гамма-процентный ресурс (Т<sub>γ</sub>) микросхем при γ=95% 200000 ч</p> <p>Минимальный срок сохраняемости микросхем (Т<sub>см</sub>) при их хранении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет;</li> <li>- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;</li> <li>- под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру ( в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.</li> </ul> <p>Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.</p>
<b>ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ</b>
<p>Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕЯР.431200.150 - 31 ТУ; а микросхем с индексом "ОСМ" - АЕЯР.431200.150-31 ТУ и ПО.070.052 в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.</p> <p>Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.</p>